

عنوان مقاله:

ساختار، ویژگیها و کاربردهای GaN

محل انتشار:

اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران (سال: 1391)

تعداد صفحات اصل مقاله: 5

نویسندگان:

محمد مهدی کارخانه چی

شقایق گمار - دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشکده فنی مهندسی

الهه اسکندری

خلاصه مقاله:

کاربرد نیمه هادی ها در زندگی امروزه حقیقتی غیر قابل انکار است. از این میان به دلیل افزایش تقاضا کاربردهای با پهنای باند بالا رو به افزون است. از این رو نیمه رساناهای با گاف انرژی بالا جهت کاربردهای الکترونیکی با توان بالا بسیار مورد توجه طراحان قرار گرفته است. از جمله این کاربردها فرستنده های میکروویوی ارتباطات و رادار هستند. به نظر می رسد GaN به دلیل داشتن گاف انرژی بالا در تکنولوژی وسایل و مواد نوید بخش باشد. در این نوشتار به ساختار، کاربرد و چالش های پیش روی این نیمه هادی پر کاربرد پرداخته شده است

کلمات کلیدی:

گاف انرژی، تقویت کننده های توان GaN

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/193219>

